



(11)Publication number:

2003-213017

(43) Date of publication of application: 30.07.2003

(51)Int.CI.

CO8J 5/24 B32B 15/08 B32B 17/04 // CO8L 63:00

(21)Application number: 2002-008766

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

17.01.2002

(72)Inventor: ABE NORIHIRO

**OHORI KENICHI** TAKEDA YOSHIYUKI **KAKIYA MINORU** KAMOSHITA SHINICHI

(54) METHOD FOR PRODUCING PREPREG

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for producing a prepreg having decreased void and dent on the surface of the prepreg or in the prepreg.

SOLUTION: The void and dent on the surface of or in a prepreg are decreased by sandwiching the prepreg with releasable films and evacuating, heating and pressing the product.

#### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-213017 (P2003-213017A)

(43)公開日 平成15年7月30日(2003.7.30)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	ΡI		2.77-1°/40d4\			
	<b>設別記号</b>				デーマコート*(参考)	
CO8J 5/24	CFC		Б/24	CFC	4F072	
B 3 2 B 15/08		B32B 19	5/08	J	4F100	
17/04		17	7/04	A		
// C08L 63:00		C08L &	3: 00	<b>Z</b>		
		審査請求 ラ	未請求	請求項の数3	OL (全 5 頁)	
(21) 出願番号	特顧2002-8766(P2002-8766)	(71) 出願人	00000	4455	-	
			日立们	比成工業株式会社		
(22)出顧日	平成14年1月17日(2002.1.17)		東京都	<b>取新宿区西新宿2丁</b>	目1番1号	
		(72)発明者	阿部	紀大		
		(1-77-77		下館市大字小川150	0.2840 日文化成	
				(式会社下館事業所)		
		(72)発明者			(1	
•		(12)光明白			and the contract of the	
		·		下館市大字小川150		
				村式会社下館事業所	<b>73</b>	
		(72)発明者	武田	良幸		
			茨城県	下館市大字小川150	00番地 日立化成	
			工業核	<b>株式会社下館事業所</b>	内	
	•				最終頁に続く	

### (54) 【発明の名称】 プリプレグの製造方法

(57)【要約】

【課題】 プリプレグ表面および内部のボイド、凹みを 低減する方法を提供する。

【解決手段】 プリプレグを離型性のあるフィルムでは さみ、さらに減圧、加熱、加圧してプリプレグ表面及び 内部に存在するポイド、凹みを低減する。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】樹脂ワニスを繊維基材に含浸させ、加熱乾燥して得られたプリプレグの両側に、離型性のフィルムを配し、減圧、加熱、加圧することを特徴とするプリプレグの製造方法。

【請求項2】離型性のフィルムを配し、減圧、加熱、加 圧する際の加熱温度が、プリプレグに含浸された樹脂の 軟化温度以上であることを特徴とするプリプレグの製造 方法。

【請求項3】上記製造方法により得られたプリプレグを 用いて得られる金属箔張積層板およびプリント配線板。 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、プリプレグの製造 方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】電子機器の小型、軽量、高速、高機能化 の要求に対して、半導体は集積度がますます増大し、多 ピン、狭ピッチ化が進んでいる。一方、半導体実装方式 もQFP等のパッケージを用いた実装方式に加え、半導 体をベアチップのまま基板上に搭載するフリップチップ 実装も実用化されており、微細化、多様化の傾向を示し ている。このような状況の中で、プリント基板もさらな る基板サイズの縮小や軽量化、高密度配線化を実現しな ければならない。これまで、一般的に用いられてきた多 層基板は、ドリル穴加工によって形成された貫通穴を介 して、銅めっきにより層間を電気的に接続しているスル ーホール構造である。しかしながら、基板の高密度化、 高多層化が進むにつれて、スルーホール数はますます増 加し、スルーホール自体が基板の小型化に対して障害と なってきている。このような課題に対し、多層基板業界 では種々の新しい多層基板が開発されている。まず、現 状のドリルを用いた銅めっきスルーホール基板技術の延 長上にある技術として、SVH(Semi-Buried Via Hol e) 多層基板がある。SVH基板は、貫通スルーホール だけでなく、表層部だけピア接続を行う方法で、貫通ス ルーホール基板に比べ高密度な配線が可能となる。この 方法によれば、表面には挿入部品用の貫通穴しか存在せ ず、高密度な部品実装が可能となる。しかし、これらの 技術はこれまでの多層化技術の改良であり、今後の小径 穴明けに対してドリル加工が困難となり、今以上にドリ ル加工のコスト比率が高くなることや、銅めっきが必要 な点は変わらない。

【0003】そこで、IVH(Interstitional Via Hole)によって任意の層間の電気的接続が可能であり、導電ペーストを用いるため銅めっきが不要なプリント配線板の製造方法が提案されている。この手法により製造される多層プリント配線板は、下記工程により製造されるため(図1参照)、すべての層間でIVH構造が可能であり、部品ランド直下の層間接続をとることも可能とな

る。さらに、めっきスルーホールが全くなく、どの層を も任意な接続が可能である。従って、小型化が可能であ り、配線長が短くなり、高速回路対応にも適している。

- (1) プリプレグに対し、レーザーによりピア加工を行う。
- (2) ピアに導電性ペーストを充填。
- (3) 銅箔積層 (熱プレス)
- (4) パターンニング (エッチング)
- (5) スタッフ
- (6) 多層化 (熱プレス)
- (7) パターンニング (エッチング)

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】よって、Bステージ状 態のプリプレグに穴明けし、導電ペーストを充填した後 に、積層(熱プレス)を行うこの工法は、プリプレグ表 面または内部にボイドや凹みが存在する場合、積層時の 樹脂流れ等により導電ペーストがボイドや凹みに流れ込 み、滲みが発生する恐れがある。導電ペーストが滲んだ 場合、隣接するピアや近傍の回路とのショート、電食に よる不具合等が発生する可能性があるため、プリプレグ の表面は、ボイドや凹みが極力ないことが望まれる。し かしながら、繊維基材に樹脂ワニスを含浸させて加熱乾 燥して得られるプリプレグは、加熱により樹脂ワニス中 の溶剤分を揮発させる都合上、溶剤分の急激な揮発によ り、プリプレグ表面にボイドや発砲状の凹みを生じるこ とが少なくない。 プリプレグ表面のボイドや凹みを低減 するには、塗工条件の調整や高沸点溶剤の適用等の手法 がある。塗工条件の調整は、加熱乾燥初期の温度を低く 抑え、溶剤の急激な揮発を防ぐものであるが、樹脂ワニ スの樹脂分、粘度、比重、温度により繊維基材への含浸 状態や表面状態が左右されるため、ボイドや凹みの状態 のばらつきが大きく、効果も完全なものとはなりにく い。また、高沸点溶剤の適用は、高沸点溶剤の沸点の高 さを利用して溶剤の急激な揮発を抑えるものであるが、 プリプレグへの残留揮発分の増加を招き、耐熱性の低下 等の問題を生じるため、あまり沸点の高いものが使用で きないため、効果が得られにくい。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明では、プリプレグの両側に離型性のフィルムを配し、その後減圧し、プリプレグに含浸された樹脂の軟化温度以上に加熱し、加圧することによって、プリプレグ表面に生じたボイドや凹みを低減させることを特徴とする。

#### (1) プリプレグ

適用されるプリプレグは、何ら限定されるものではなく、使用される基材はガラス繊維の織布、不織布、有機 繊維の織布または不織布等が挙げられ、基材に含浸される樹脂ワニスには熱硬化性樹脂を用いることができ、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、ポリイミド樹脂等が挙げられ、それらを変性または混合しても良く、また必要に 応じて、有機および無機の充填剤を配合しても良い。

#### (2) 離型性フィルム

リプレグの軟化点以上に加熱するため、プリプレグと軟

#### (3) 減圧条件

減圧条件は10~0.1hPaが望ましい。大気圧~1 OhPaでは、真空度が低いためポイドや凹み内の空気 を抜くことが難しく、0.1hPa以下では、温度条 件、加圧条件にもよるが、真空度が高いため密着が強く なりすぎ、フィルムの粘着が起こり易くなる。

#### (4) 加圧圧力

加圧圧力は高いほどボイドや凹みを埋め込む効果が大き いが、高すぎると樹脂の流れ出しが多くなり、プリプレ グの樹脂量が減少してしまう。よって、0.3~3.0 MPa程度が好ましい。

#### (5) 加熱温度

原理上プリプレグの軟化温度以上で効果が得られるが、 あまり温度が高い場合、フィルムへの粘着、硬化反応の 進行による硬化性能の著しい変化が起こるため、軟化開 始温度+0~50℃程度が望ましいが、特に+20~5 0℃が好ましい。ここで軟化温度は、下記のように定義 した。 Du Pont 社製TMA (Thermomechanical Ana lyzer ) 943にて、5mm×5mmのプリプレグにゅ 1 mmのプローブをのせ、2 g 荷重し、昇温速度5℃/ 分で200℃まで温度を上げる。温度が上がり、プリブ レグの樹脂が軟化していくと、プローブにかかる圧力で プロープ接触部のプリプレグの厚さが減少する。プリプ レグの元の厚さが2%減少した時の温度を軟化温度とし た (図2参照)。

#### (6) 加熱時間

ボイドや凹み内の空気が充分抜けきる時間行う必要があ るが、長時間加熱を続けると硬化性能が変化するため、 30~120秒程度が好ましい。

#### [0006]

【作用】本発明によれば、プリプレグの両側に離型性の フィルムを配し、減圧することでプリプレグ表面のボイ ドや凹み内の空気が抜け易い状態にし、そこで軟化温度

・プロム化エポキシ樹脂

エピコート504B80 (ジャパンエポキシレジン株式会社製、商品名)

90重量部

・クレゾールノボラック型エポキシ樹脂 N-673-80M(大日本インキ化学工業株式会社製、商品名)

10重量部

・硬化剤 ジシアンジアミド

・硬化促進剤

2-エチルー4-エチルイミダゾール

1. 5 重量部

0.05重量部

し、シリカ60重量部を配合し、樹脂ワニス中の溶剤以

離型性フィルムは、何ら限定されるものではないが、ブ 化反応を起こさず、使用後に剥離し易いものが望まし

#### (1) 実験条件

[0007]

・使用機器: (株) 名機製作所製MLVP-500真空 加圧式ラミネータ

以上の温度に加熱し、加圧することによってポイドや凹

【実施例】以下、本発明の実施例および比較例によっ

て、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明は、こ

・離型性フィルム: Si系の離型剤を塗布した厚さ約2 5μmのPET (ポリエチレンテレフタレート) フィル ムを用いた。

・減圧条件: 4 h P a

·加圧圧力: 1. 76MPa

みを低減することが可能となる。

れらの実施例に限定されるものではない。

・加熱温度:60℃、90℃、120℃、150℃

加熱時間:60秒

#### (2) 評価方法

①プリプレグ表面ボイド、凹みサイズ

プリプレグの表面を顕微鏡にて観察し、表面に存在する ボイド、凹みの大きさを測定しマーキングする。減圧、 加熱、加圧後に同様に観察を行い、マーキングしたボイ ド、凹みの大きさを測定する。

#### ②フィルムの粘着

フィルムへの粘着は、処理後にフィルムを剥離し、剥離 したフィルムを観察し、樹脂の粘着の有無を調べた。

#### ③硬化時間

プリプレグをもみほぐして得られた樹脂粉0.5gを1 70℃に加熱した熱盤上に載せ、溶融した樹脂を一定速 度(2回/秒)で攪拌し、溶融した樹脂が硬化するまで の時間。

#### ④軟化温度

Du Pon t社製TMA (Thermomechanical Analyzer ) 943にて、5mm×5mmのプリプレグにø1m mのプローブを載せ、2g荷重し、昇温速度5℃/分で 200℃まで温度を上げる。プリプレグの元の厚さが2 %減少した時の温度を軟化温度とした(図2参照)。

【0008】実施例1~実施例2

熱硬化性樹脂として、以下の組成のものを用いた。

こられの組成を、メチルエチルケトン50重量部に混合

外の固形分が66.7重量%となるように樹脂ワニスを 調整した。繊維基材として、坪量210g/m²、幅 1050mm、厚さ0.2mmのガラス織布 (MIL規 格:7629タイプ)を用い、ガラス織布重量と樹脂硬 化物重量(無機充填剤を含む)の合計を100重量%と した時の樹脂硬化物の割合が48重量%となるように調

整し、9m/分の速度で、含浸して170℃の乾燥塔内 を通過させプリプレグを作製した。真空ラミネータの加 熱温度を90℃、および120℃の2条件にて、加熱、 減圧 (4 h P a) 、加圧 (1.76 M P a) を行った。 【0009】実施例3~実施例4 熱硬化性樹脂として以下の組成のものを用いた。

・プロム化エポキシ樹脂

エピコート504B80 (ジャパンエポキシレジン株式会社製、商品名)

90重量部

・クレゾールノボラック型エポキシ樹脂 N-673-80M (大日本インキ化学工業株式会社製、商品名)

10重量部

• 硬化剂 ジシアンジアミド

・硬化促進剤

1. 5重量部

0.05重量部

2-エチル-4-メチルイミダゾール これらの組成を、メチルエチルケトン50重量部に混合

76MPa) を行った。

し、シリカ30重量部を配合し、樹脂ワニス中の溶剤以

実施例1~2で得られたプリプレグにおいて、加熱温度 を60℃および150℃の2条件とした。実験結果を表 1に示す。

外の固形分が66.7重量%となるように樹脂ワニスを 調整した。繊維基材として、坪量210g/m²、幅 1050mm、厚さ0. 2mmのガラス織布 (MIL規 格:7629タイプ)を用い、ガラス織布重量と樹脂硬 化物重量(無機充填剤を含む)の合計を100重量%と した時の樹脂硬化物の割合が45重量%(無機充填剤を 含む)となるように調整し、9m/分の速度で、含浸し て170℃の乾燥塔内を通過させプリプレグを作製し た。真空ラミネータの加熱温度を90℃、および120 ℃の2条件にて、加熱、減圧(4 h P a)、加圧(1.

【0011】比較例3~比較例4

【0010】比較例1~比較例2

実施例3~4で得られたプリプレグにおいて、加熱温度 を60℃および150℃の2条件とした。実験結果を表 1に示す。

[0012]

【表1】

<b>プリス゚レク</b> ゙		加熱	ポイド、凹み径μm		フィル	硬化時間 (秒)	
項目	樹脂軟	温度			ムへの		
	化温度	(°C)	処理前	処理後	粘着	処理前	処理後
実施例 1	7 2 ℃	90	500	200	なし	118	115
実施例 2		120	~600	0	なし		113
実施例3	69℃	90	150	0	なし	121	120
実施例4		120	~200	0	少		117
比較例1	72℃	60	500	500 600	なし	118	117
比較例2		150	~600	. 0	大		8 7
比較例3	6 9 ℃	60	150	150 200	なし	121	121
比較例4		150	~200	0	<b>*</b>		8 9

#### [0013]

【発明の効果】本発明によれば、プリプレグの両側に離 型性のフィルムを配した後、減圧し、樹脂の軟化温度以 上まで加熱し、その後加圧することにより、プリプレグ 表面および内部のボイド、凹みを低減することが可能と

なる。本発明により得られたプリプレグは、表面および 内部のボイド、凹みが少ないため、プリプレグに直接穴 を明け、導電ペーストを用いて層間接続を行う多層プリ ント配線板への適用に好適である。

#### フロントページの続き

(72)発明者 垣谷 稔

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成

工業株式会社下館事業所內

(72)発明者 鴨志田 真一

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成

工業株式会社下館事業所内

Fターム(参考) 4F072 AG03 AG16 AG18 AG19 AL13

4F100 AB01B AB33B AG00 AK01A AK53 BA02 CA02 DG01A DG12 DH01A EJ82A EJ86A

EJ97 GB43

THIS PAGE BLANK (USPTO)

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)